

2SD334

シリコン NPN 拡散接合メサ形/Si NPN Diffused Junction Mesa

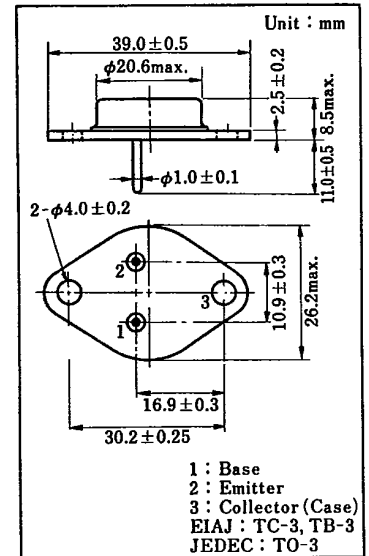
大電力増幅用/High Power Amplifier

■ 特徴/Features

- 安全動作領域 (ASO) が広い。/Wide area of safe operation (ASO)
- 定電圧電源の制御回路に最適です。/Suitable for voltage regulator

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	110	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	6	A
ベース電流	I_B	3	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	75	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-65\sim+150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			50	μA
		$V_{CB}=110\text{ V}, I_E=0$			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=50\text{ mA}, I_B=0$	80			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=1\text{ mA}, I_C=0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=1\text{ A}^{*2}$	40		260	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=1\text{ A}^{*2}$			2.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{ A}, I_B=0.5\text{ A}^{*2}$			2	V
シャ断周波数	$f_{\alpha e}$	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$		25		kHz

*2 パルス測定/Pulse Test

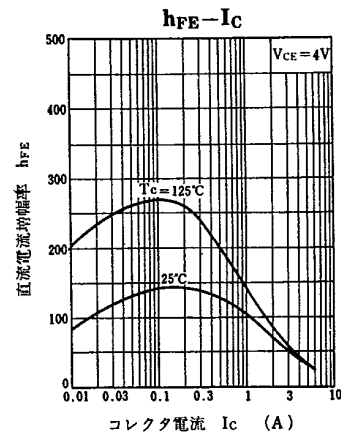
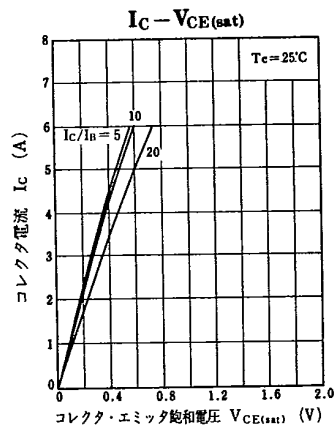
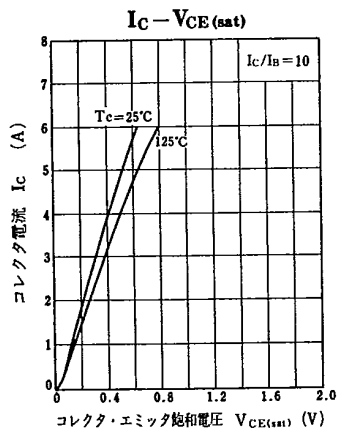
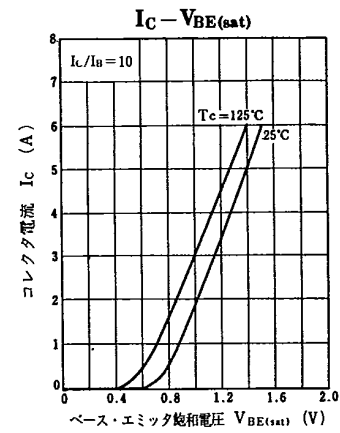
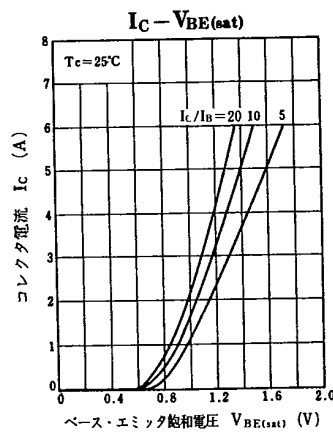
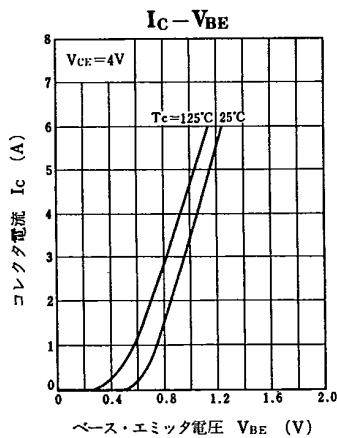
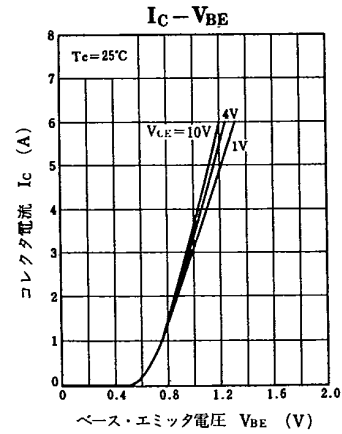
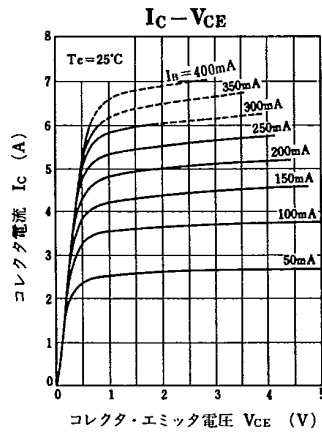
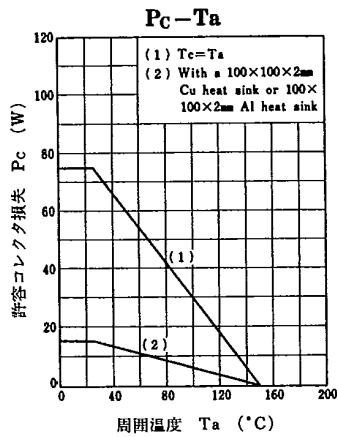
*1 h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

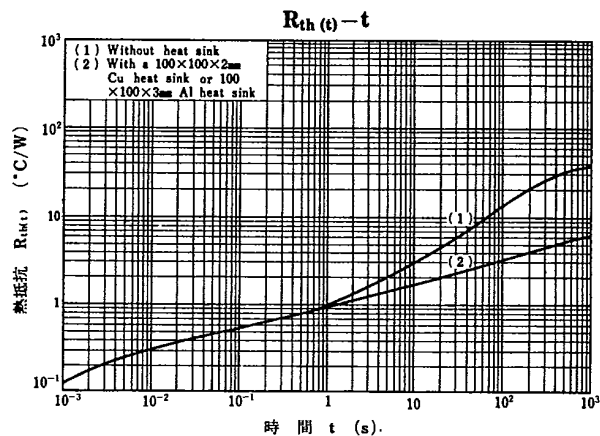
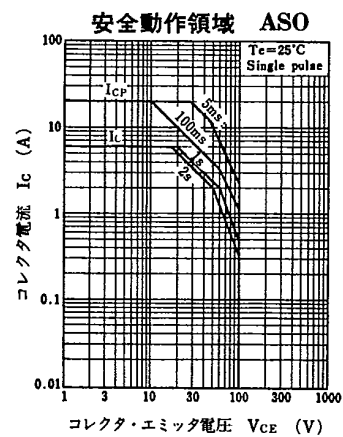
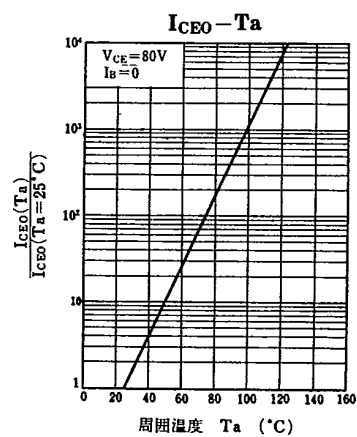
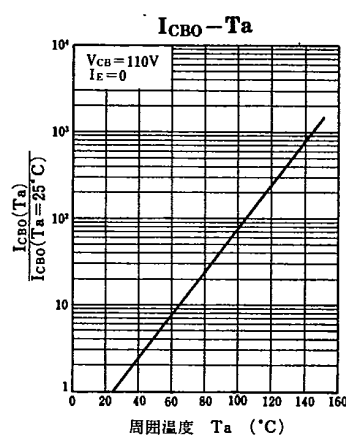
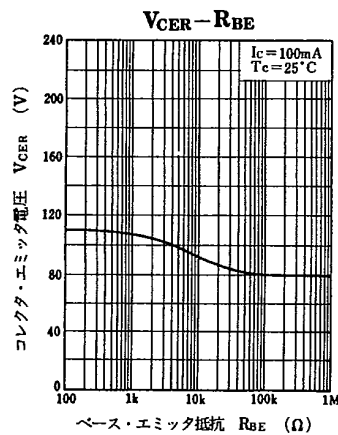
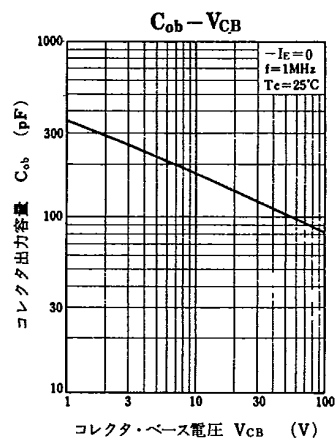
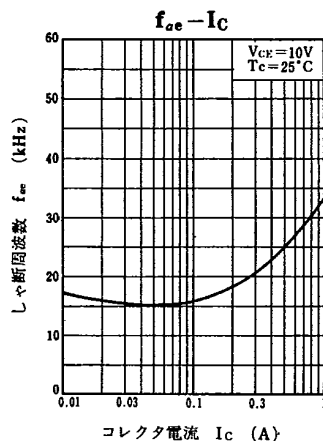
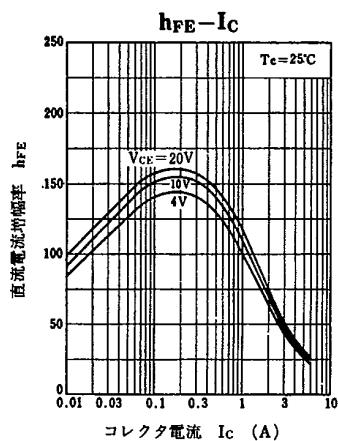
Class	R	O	Y
h_{FE}	40~80	70~150	130~260

トランジスタ

T-33-13

2SD334





トランジスタ

2SD352

2SD352

ゲルマニウム NPN 合金接合形/Ge NPN Alloy Junction (UL 形)

中出力電力増幅用/Medium Power Amplifier

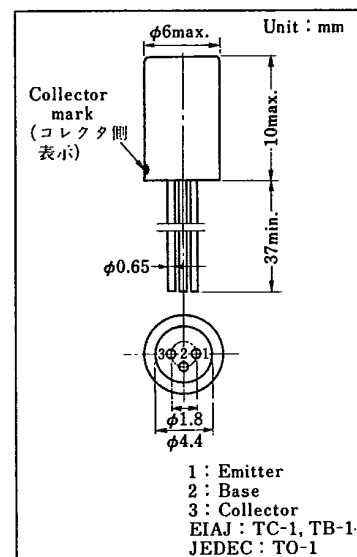
2SB324 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with 2SB324

■ 特 徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性がよい。/Good linearity of h_{FE}
- 2SB324 とコンプリメンタリペアで出力 2 W が得られます。/
2 W output in complementary pair with 2SB324

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

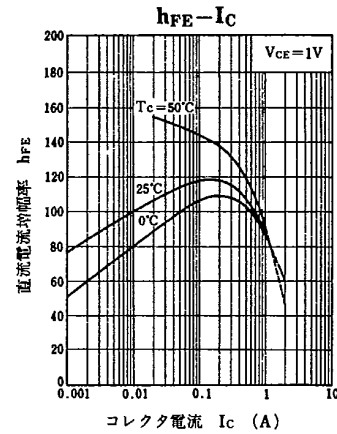
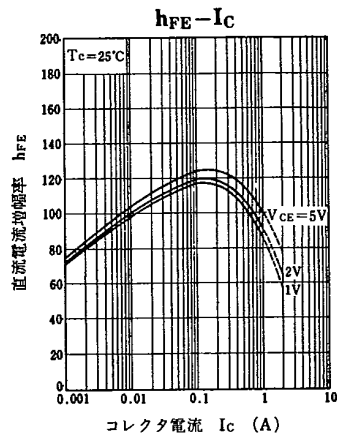
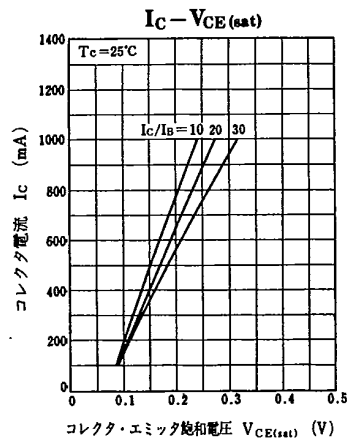
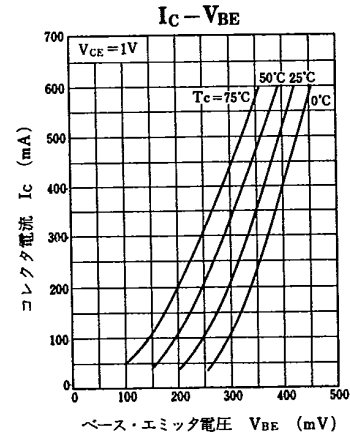
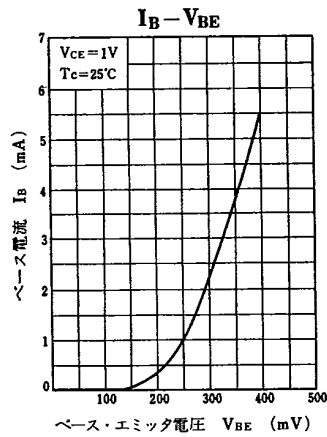
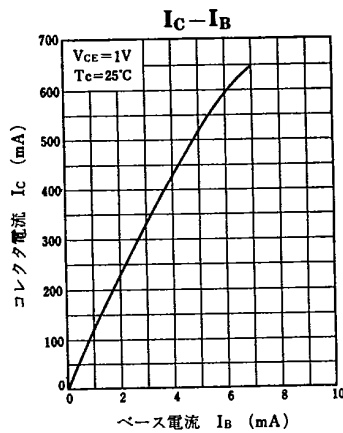
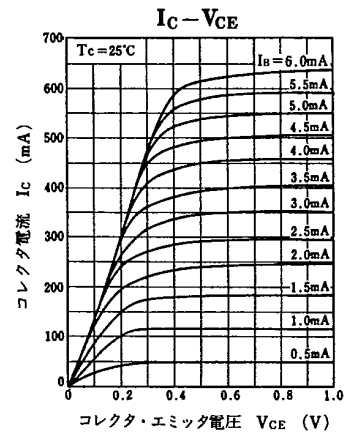
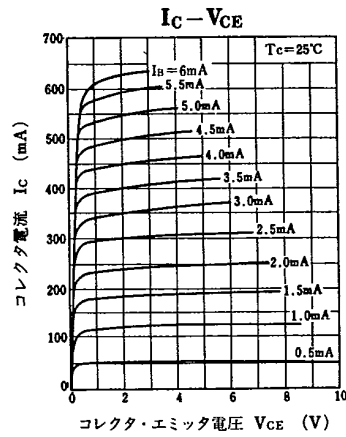
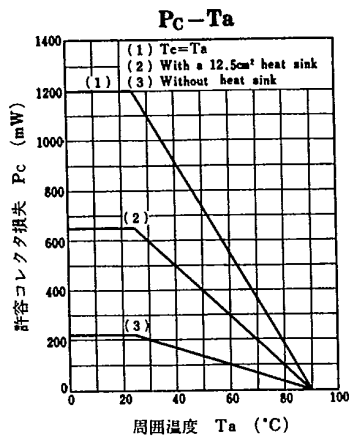
Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	32	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	1	A
コレクタ損失	P_C^*	650	mW
接合部温度	T_j	90	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +90$	$^\circ\text{C}$

* With a 12.5 cm^2 heat sink■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			25	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=200\text{ }\mu\text{A}, I_E=0$	32			V
直流電流増幅率	h_{FE2}^*	$V_{CB}=0, -I_E=300\text{ mA}$	69		273	
シャ断周波数	$f_{\alpha e}$	$V_{CB}=2\text{ V}, -I_E=10\text{ mA}$	10			kHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{ mA}, I_B=50\text{ mA}$		0.17		V
雑音指数	NF	$V_{CB}=5\text{ V}, -I_E=5\text{ mA}, f=1\text{ kHz}$			25	dB

* h_{FE2} ランク分類/ h_{FE2} Classifications

Class	K	H	E	B	S
h_{FE2}	69~125	83~150	100~177	120~200	150~273



トランジスタ

T-29-11

2SD352

